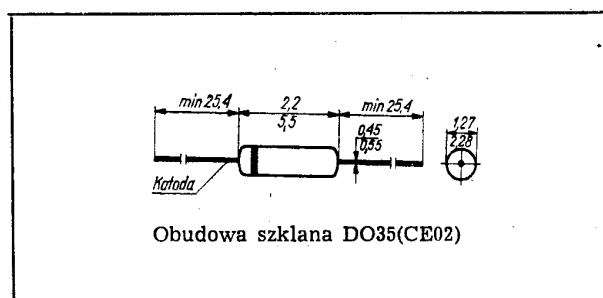


* BAYP94, BAYP94A, BAYP95, BAYP95A

Diody krzemowe epiplanarne są przeznaczone do stosowania w układach impulsowych i przełączających o bardzo dużej szybkości oraz innych zastosowaniach profesjonalnych.



DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych

		BAYP-			
		-94	-95	-94A	-95A
Napięcie wsteczne	U_R	25	50	30	V
Szczytowe napięcie wsteczne	U_{RM}	35	75	40	V
Średni prąd wyprostowany	I_o		150		mA
Prąd przewodzenia	I_F		200		mA
Szczytowy prąd przewodzenia	I_{FM}		450		mA
Niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia	I_{FSM}		2000		mA
Moc całkowita	P_{tot}		500		mW
Temperatura złącza	t_j		473 K (200°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	208...473 K (-65...+200°C)			

Dioda BAYP95

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25°C)}$

		min.	typ.	maks.	
Prąd wsteczny przy $U_R = 50 \text{ V}$	I_R	—	8	50	nA
Napięcie przebicia przy $I_R = 5 \mu\text{A}$	$U_{(BR)}$	75	100	—	V
Napięcie przewodzenia przy $I_F = 0,1 \text{ mA}$	U_F	—	0,5	—	V
$I_F = 20 \text{ mA}$		—	0,76	—	V
$I_F = 50 \text{ mA}$		—	0,84	1	V

32 Elementy półprzewodnikowe

SWW 1156-131

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25°C)}$

		min.	typ.	maks.	
Czas przełączania przy $I_F = 10 \text{ mA}$; $U_R = 6 \text{ V}$; $i_{rr} = 1 \text{ mA}$; $R_L = 100 \Omega$	t_{rr}	—	1,2	2	ns
przy $I_F = 10 \text{ mA}$; $I_{RM} = 10 \text{ mA}$; $i_{rr} = 1 \text{ mA}$		—	—	4	ns
Pojemność diody przy $f = 1 \text{ MHz}$; $U_R = 0 \text{ V}$	C_r	—	1	2	pF

Dioda BAYP95A

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25°C)}$

Prąd wsteczny przy $U_R = 50 \text{ V}$	I_R	—	10	50	nA
Napięcie przebicia przy $I_R = 5 \mu\text{A}$	$U_{(BR)}$	75	100	—	V
Napięcie przewodzenia przy $I_F = 0,1 \text{ mA}$	U_F	—	0,52	—	V
$I_F = 10 \text{ mA}$		0,7	0,76	0,81	V

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25°C)}$

Czas przełączania przy $I_F = 10 \text{ mA}$; $U_R = 6 \text{ V}$; $i_{rr} = 1 \text{ mA}$; $R_L = 100 \Omega$	t_{rr}	—	1,2	2	ns
przy $I_F = 10 \text{ mA}$; $I_{RM} = 10 \text{ mA}$; $i_{rr} = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	—	—	4	ns
Pojemność diody przy $f = 1 \text{ MHz}$; $U_R = 0 \text{ V}$	C_r	—	1	2	pF

Dioda BAYP94

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25°C)}$

Prąd wsteczny przy $U_R = 25 \text{ V}$	I_R	—	5	100	nA
Napięcie przebicia przy $I_R = 5 \mu\text{A}$	$U_{(RB)}$	35	55	—	V
Napięcie przewodzenia przy $I_F = 0,1 \text{ mA}$	U_F	—	0,52	—	V
$I_F = 20 \text{ mA}$		—	0,8	—	V
$I_F = 30 \text{ mA}$		—	0,84	1	V

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298\text{ K}$ (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Czas przełączania przy $I_F = 10\text{ mA}$; $U_R = 6\text{ V}$; $i_{rr} = 1\text{ mA}$; $R_L = 100\ \Omega$	t_{rr}	—	1,2	2	ns
przy $I_F = 10\text{ mA}$; $I_{RM} = 10\text{ mA}$; $i_{rr} = 1\text{ mA}$	t_{rr}	—	—	4	ns
Pojemność diody przy $f = 1\text{ MHz}$; $U_R = 0\text{ V}$	C_r	—	—	4	pF

Dioda BAYP94A**Parametry statyczne; $t_{amb} = 298\text{ K}$ (25°C)**

Prąd wsteczny przy $U_R = 30\text{ V}$	I_R	—	5	50	nA
Napięcie przebicia przy $I_R = 5\ \mu\text{A}$	$U_{(BR)}$	40	60	—	V

	min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia U_F przy $I_F = 0,1\text{ mA}$	—	0,52	—	V
$I_F = 2\text{ mA}$	0,62	0,66	0,7	V

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298\text{ K}$ (25°C)

Czas przełączania przy $I_F = 10\text{ mA}$; $U_R = 6\text{ V}$; $i_{rr} = 1\text{ mA}$; $R_L = 100\ \Omega$	t_{rr}	—	1,2	2	ns
przy $I_F = 10\text{ mA}$; $I_{RM} = 10\text{ mA}$; $i_{rr} = 1\text{ mA}$		—	—	4	ns
Pojemność diody przy $f = 1\text{ MHz}$; $U_R = 0\text{ V}$	C_r	—	—	2	pF

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 43 14 31 ÷ 39
Teleks: 813 219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERRADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 28 94 11; 28 61 74
Teleks: 813 435